

เอกสารอ้างอิง

1. Yuan, Luck C.L., and Wu, Chien - Shiung. Methods of Experimental Physics. Vol. 5 : Part A , Nuclear Physics. New York : Academic Press , 1972.
2. Price , W.J. Nuclear Radiation Detection. New York : McGRAW - HILL , 1958.
3. Korff , Serge A. Electron and Nuclear Counters. New York : Nostrand , 1947.
4. Sharpe , J. Nuclear Radiation Detectors . London : Methuen , 1955.
5. Rossi, Bruno B., and Staub , Hams H. Ionization Chamber and Counters. New York : McGRAW - HILL , 1949.
6. Faires , R.A., and Parks , B.H. Radioisotope Laboratory Techniques. London : J.W. Arrowsmith , 1958.
7. Lapp, Ralph E., and Andrews, Haward L. Nuclear Radiation Physics. 3d ed. Sydney : Prentice , 1964.
8. Singru, R.M. Introduction to Experimental Nuclear Physics. New Delhi : Wiley Eastern Private, 1972.

9. U.S. Department of Health , Education and Welfare. Radiological Health Handbook . Reviewed Edition September , 1960 : 223 , 232 , 247 , 248 , 400.
10. Chase , Robert L. Nuclear Pulse Spectrometry. London : McGRAW - HILL BOOK , 1961.
11. Winch , Ralph P. Electricity and Magnetism. 2d ed. Massachusetts : Prentice - Hall , 1976.
12. The Radiochemical Centre. "Mossbauer Sources". Technical Bulletin 74/3 (1974) : 6, 14.
13. Benade , A.H. , and Chrien , R.E. "Sewing - Needle Proportional Counter" American Journal of Physics 25 (May 1957) : 280 - 284.
14. Charpak , Georges. "Multiwire and Drift Proportional Chambers". Physics Today , 10 (October 1978) : 23 - 30.
15. Frisch , O.R. Progress in Nuclear Physics. Vol. 3 London : Pergamon Press , 1953.

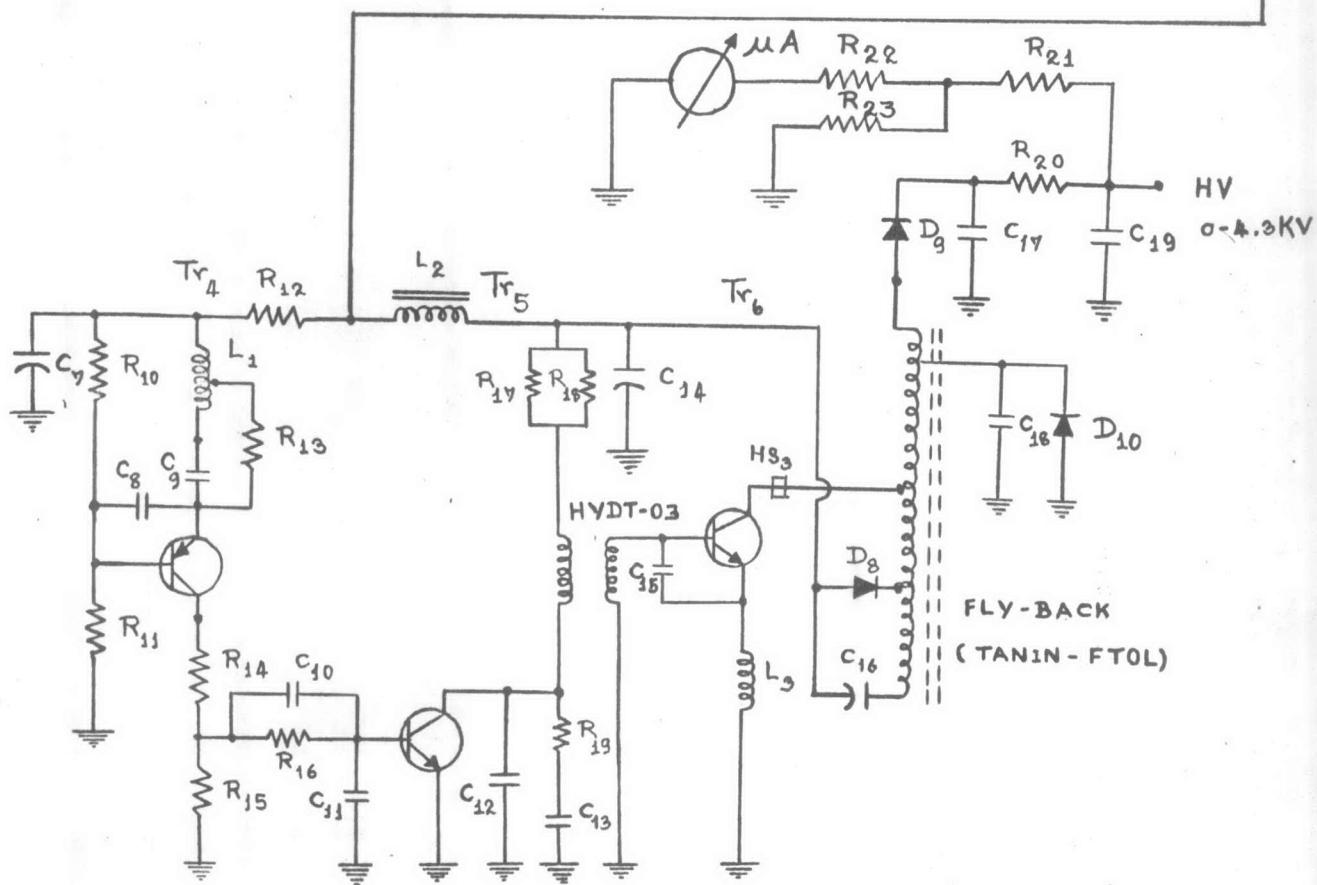
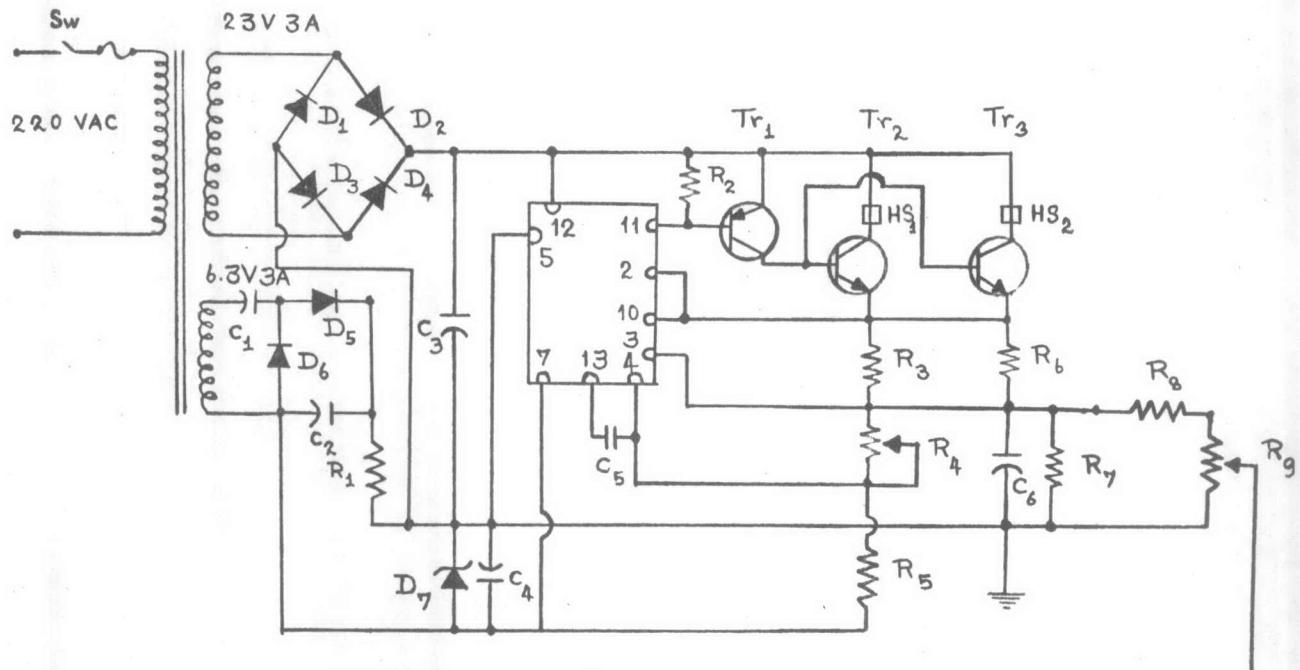
## ภาคผนวก

### ปรากฏการณ์โคโรนาศิษชาร์จ (11)

ตามปกติในอากาศมีอิเลคตรอนและไอออนบางอิสระเกิดจากการแผ่รังสีคอสมิก (cosmic radiation) และกัมมันตภาพรังสีบริเวณนี้ (local radioactivity) อิเลคตรอนและไอออนบางเหล่านี้จะถูการะเบิด เมื่อยุบในสนามไฟฟ้า ซึ่งอิเลคตรอนเคลื่อนที่สวนทางกับสนามไฟฟ้าและไอออนบางเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกับสนามไฟฟ้า พลังงานของอิเลคตรอนและไอออนบางที่ได้รับจากสนามไฟฟ้าจะสูญเสียไปในรูปของความร้อน เมื่ออนุภาคเหล่านี้ชนแบบยืดหยุ่น (elastic collision) กับโมเลกุลของอากาศเป็นตัวกลาง ถ้าความเข้มของสนามสูงพอ เมื่ออิเลคตรอนอนุภาคหนึ่งได้รับพลังงานจากสนามมากพอสำหรับระยะเฉลี่ยอิสระหนึ่ง (mean free path) อิเลคตรอนจะชนโมเลกุลของอากาศให้เกิดการเกิดไอออนในการชนแบบไม่ยืดหยุ่น (inelastic collision) ที่ปลายของระบบเฉลี่ยอิสระนี้ อิเลคตรอนเหล่านี้จะผลิตไอโอดอนมากขึ้นทำให้อากาศเป็นสีน้ำเงินบริเวณใกล้ ๆ จุดที่มีประจุ (charged point) สนามไฟฟ้าอาจมีค่ามากพอทำให้เกิดการนำไฟฟ้า (conduction) ถ้าจุดนี้เป็นประจุบวก อิเลคตรอนในอากาศจะเคลื่อนมาหา และรวมกับประจุที่จุดนั้นกลายเป็นกลาง ในทันทีเดียวกัน ถ้าจุดนี้เป็นประจุลบ ไอออนบางจะเคลื่อนที่ไปรวมกับประจุลบที่จุดนั้นเป็นกลาง

เมื่อร่วมตัวใหม่โดยตรง (direct recombination) ของอิเลคตรอนและไอออนบาง เนื่องจากมีเหล่งกำเนิดอิเลคตรอนและไอออนบางในอากาศใกล้ ๆ จุดนี้ เมื่อเกิดการรวมกันใหม่มีการรายพลังงานออกมาน้ำหนักพลังงานบางช่วงในสเปกตรัม ตามองเห็นเป็นแสงสว่างใกล้ ๆ จุดนี้ แสงที่เห็นเป็นบางส่วนที่เกิดจากพลังงานที่ 2 หรือการรวมใหม่แสดงถึงการเกิดศิษชาร์จของจุดต่าง ๆ ในอากาศ เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "โคโรนา" (corona)

ในการสร้างรายลับไฟสูงจึงต้องพยายามไม่ให้มีจุดแหลมหรือมน เพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานโดย "โกรโน ตีสชาร์จ" ถ้าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างเส้นลวดในสายต่าง ๆ หรือระหว่างเส้นลวดกับพื้นดินมีค่ามาก ความเข้มสนามไฟฟ้าข้างนอกลวดจะแรงมากพอจะทำให้เกิดโกรโน ถึงแม้ว่าจุดต่าง ๆ ไม่มี จึงทำให้ลวดซึ่งอยู่ในสายลับกำลังเกิดสว่าง ซึ่งทำให้สูญเสียกำลังไฟฟ้าไป

HIGH VOLTAGE POWER SUPPLY.

อุปกรณ์ของเครื่องจ่ายไฟสูง

1. ไดโอด D<sub>1-4</sub> 3A 100V 4 ตัว

D<sub>5-6</sub> 0.5A 50V 2 ตัว

D<sub>7</sub> zener diode 6.8V 400mW 1 ตัว (N754A)

D<sub>8</sub> SB-2

D<sub>9</sub> HV rectifier diode M.F. 25/lb

D<sub>10</sub> V03E

2. ทรานซิสเตอร์ Tr<sub>1</sub> 2N2905 1 ตัว

Tr<sub>2-3</sub> 2N3055 2 ตัว

Tr<sub>4</sub> 2SA-344 E 1 ตัว

Tr<sub>5</sub> 2S-C-1213 B/C 1 ตัว

Tr<sub>6</sub> 2S-C-681AYL 1 ตัว

3. ไอซี RC Y23 1 ตัว

4. ทรานฟอร์มเมอร์ 3A 220V 1 ตัว

HYDT-03 1 ตัว

FLY-BACK (TANIN-FTOL) 1 ตัว

5. ขันติกเตอร์ L<sub>1</sub> HOSC-02

L<sub>2</sub> L802 , L<sub>3</sub> L801

6. ที่ระบายความร้อน HS<sub>1-3</sub> 3 ตัว

7 ตัวค้างมต้านทาน	R <sub>1</sub> 560 Ω	1 w
	R <sub>2</sub> 200 Ω	$\frac{1}{2}$ w
	R <sub>3</sub> 0.65 Ω	1 w
	R <sub>4</sub> VR 50 kB Ω	
	R <sub>5</sub> 6.8 kΩ	$\frac{1}{2}$ w
	R <sub>6</sub> 0.65 Ω	1 w
	R <sub>7</sub> 3k Ω	1 w
	R <sub>8</sub> 2.3 k Ω	$\frac{1}{2}$ w
	R <sub>9</sub> VR 30 kB Ω	
	R <sub>10</sub> 10 k Ω	$\frac{1}{4}$ w
	R <sub>11</sub> 82 k Ω	$\frac{1}{4}$ w
	R <sub>12</sub> 1.8 k Ω	$\frac{1}{4}$ w
	R <sub>13</sub> 27 Ω	$\frac{1}{4}$ w
	R <sub>14</sub> 220 Ω	$\frac{1}{4}$ w
	R <sub>15</sub> 560 Ω	$\frac{1}{4}$ w
	R <sub>16</sub> 560 Ω	$\frac{1}{4}$ w
	R <sub>17</sub> 82 Ω	$\frac{1}{2}$ w
	R <sub>18</sub> 82 Ω	$\frac{1}{2}$ w
	R <sub>19</sub> 220 Ω	$\frac{1}{2}$ w
	R <sub>20</sub> 1M Ω	5 w

$R_{21}$  50 M $\Omega$   $\frac{1}{2}$  w

$R_{22}$  10.3 k $\Omega$   $\frac{1}{2}$  w

$R_{23}$  20 k $\Omega$   $\frac{1}{2}$  w

8. ตัวความจุ	$c_1$	470 $\mu$ F 16V	1 ตัว
	$c_2$	200 $\mu$ F 25V	1 ตัว
	$c_3$	3,000 $\mu$ F 50V	1 ตัว
	$c_4$	1,000 $\mu$ F 16V	1 ตัว
	$c_5$	470 pF	1 ตัว
	$c_6$	500 $\mu$ F 35V	1 ตัว
	$c_7$	47 $\mu$ F 16V	1 ตัว
	$c_8$	0.01 $\mu$ F myl	1 ตัว
	$c_9$	0.068 $\mu$ F myl	1 ตัว
	$c_{10}$	0.01 $\mu$ F myl	11 ตัว
	$c_{11}$	0.0022 $\mu$ F myl	1 ตัว
	$c_{12}$	0.0022 $\mu$ F ml	1 ตัว
	$c_{13}$	0.033 $\mu$ F myl	1 ตัว
	$c_{14}$	1,000 $\mu$ F 25V	1 ตัว
	$c_{15}$	0.01 $\mu$ F myl	1 ตัว
	$c_{16}$	220 $\mu$ F 16V	1 ตัว

c<sub>17</sub> 0.05 μF 8,000 V 1 ตัว

c<sub>18</sub> 0.022 μF 1 ตัว

c<sub>19</sub> 0.05 μF 10,000 V 1 ตัว

9. ไมโครแอมมิเตอร์ 50 μA 1 ตัว

ประวัติผู้เชี่ยง

นายสมพร เจริญสุข เกิดวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2496 ที่จังหวัด  
 นครสวรรค์ สำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาการศึกษาปั้นชิต (เกียรตินิยม อันดับ 2) จาก  
 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก เมื่อปีการศึกษา 2517 ได้รับอนุกรรมการศึกษา  
 โครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2518 - 2519